09 Электронные и оптические свойства углеродных супракристаллических *SP*²-наноаллотропов

© Р.А. Браже, Р.М. Мефтахутдинов

Ульяновский государственный технический университет, 432027 Ульяновск, Россия e-mail: mrm@ulstu.ru

(Поступило в Редакцию 26 марта 2015 г. В окончательной редакции 12 октября 2015 г.)

> Исследованы электронные и оптические свойства углеродных электропроводящих двумерных супракристаллов. Методом сильной связи рассчитана их зонная структура. Показано, что одни из них принадлежат к полуметаллам, а другие — к узкозонным полупроводникам. Рассчитана оптическая проводимость супракристаллических структур. Показано, что проводимость полуметаллических супракристаллов может быть значительно выше, чем у графена. Сделаны оценки величины комплексного показателя преломления указанных супракристаллов.

Введение

В последнее время успехи в области наноэлектроники, как правило, связаны с созданием новых, зачастую не встречающихся в природе, мате- риалов. Получение графена [1,2], силицена [3], борофена [4] и других материалов, а также предсказание новых устойчивых графеноподобных двумерных структур, таких как пентагептиты [5,6], хэкелиты [7], графины [8,9], графдины [10], скварографиты [11] и т.д., породило настоящий бум в исследовании физических свойств искусственных наноматериалов. В настоящей работе исследуются электронные и оптические свойства углеродных графеноподобных планарных структур, называемых супракристаллами [12,13]. Их упругие и акустические свойства были изучены нами ранее в работах [14-16]. Рассматриваются лишь *s p*²-наноаллотропы, в которых имеются свободные электроны.

Исследуемые структуры

На рис. 1 показаны три типа исследуемых углеродных 2D-супракристаллов, обладающих $s p^2$ -гибридизацией: $(C)_{44}$ — структура, известная как октаграфен [17], содержащая 4 атома в элементарной ячейке (показана штриховой линией); $(C)_{63(12)}$, содержащая 6 атомов в элементарной ячейке, и $(C)_{664}$ с 12 атомами в элементарной ячейке. В приведенных обозначениях индексы показывают поворотную симметрию. Векторы a_1 и a_2 —



Рис. 1. Исследуемые 2D-супракристаллические структуры.



Рис. 2. Первая зона Бриллюэна: a — для структур (C)₆₃₍₁₂₎ и (C)₆₆₄, b — для структуры (C)₄₄.

векторы трансляции. В табл. 1 эти векторы, а также их длины выражены через межатомное расстояние l. Следует отметить, что у структуры (С)₄₄ межатомное расстояние внутри квадрата l_1 больше, чем расстояние между ближайшими атомами соседних квадратов l_2 . Базисные векторы прямой и обратной решеток выражены через межатомные расстояния.

На рис. 2 приведены зоны Бриллюэна (3Б) для исследуемых структур. Штрихами показана альтернативная 3Б (рис. 2, a).

Зонная структура

Зонная структура рассматриваемых наноаллотропов углерода рассчитывалась методом сильной связи. Для этого блоховская функция $2p_z$ электрона была сконструирована на основе атомных волновых функций:

$$\psi = \sum_{i=1}^{n} C_i \varphi_i (\mathbf{r} - \mathbf{R}_i),$$

где ϕ_i — базисная волновая функция, относящаяся к атому *i* внутри элементарной ячейки и имеющая радиусвектор \mathbf{R}_i , *n* — количество атомов в ячейке. Матричные

(C) ₄₄	$(C)_{63(12)}$	(C) ₆₆₄
$\mathbf{a}_1=(\sqrt{2}l_1+l_2,0)$	$\mathbf{a}_1 = \left(rac{2\sqrt{3}+3}{2}, -rac{\sqrt{3}+2}{2} ight)l$	$\mathbf{a}_1 = \left(2\sqrt{3}+1, \ -\frac{\sqrt{3}+3}{2}l\right)$
$\mathbf{a}_2=(0,\sqrt{2}l_1+l_2)$	$\mathbf{a}_2 = (0, \ \sqrt{3}+2)l$	$\mathbf{a}_2=\Big(0,\sqrt{16+rac{9\sqrt{3}}{2}}\Big)l$
$a = \mathbf{a}_1 = \mathbf{a}_2 = (\sqrt{2}l_1 + l_2)$	$a = \mathbf{a}_1 = \mathbf{a}_2 = (\sqrt{3} + 2)l$	$a = \mathbf{a}_1 = \mathbf{a}_2 = \left(\sqrt{16 + \frac{9\sqrt{3}}{2}}\right)l$
$\mathbf{b}_1 = (0, \ 1) \frac{2\pi}{a}$	$\mathbf{b}_1 = \left(rac{2}{\sqrt{3}}, \ 0 ight)rac{2\pi}{a}$	$\mathbf{b}_1 = ig(rac{2}{\sqrt{3}}, \ 0ig)rac{2\pi}{a}$
$\mathbf{b}_2 = (1, \ 0) \frac{2\pi}{a}$	$\mathbf{b}_2 = \left(1, rac{1}{\sqrt{3}} ight) rac{2\pi}{a}$	$\mathbf{b}_2 = \left(1, rac{1}{\sqrt{3}} ight)rac{2\pi}{a}$

Таблица 1. Базисные векторы прямой и обратной решеток

элементы гамильтониана

$$H_{ij} = \int \varphi_i^* H \varphi_j d\tau = V_{pp\pi}$$
 $imes \sum_{\substack{\text{ближашие} \\ \text{соседи}}} \exp[i\mathbf{k}(\mathbf{R}_j - \mathbf{R}_i)]$ (1)

записывались в приближении взаимодействия лишь между ближайшими соседями. Перекрытие волновых функций при построении гамильтониана не учитывалось.

Интегралы перескока были определены по формуле, предложенной Гудвином [18]:

$$V_{pp\pi} = V_{pp\pi}^{0} \left(\frac{r_{0}}{l}\right)^{n} \exp\left(n\left[-\left(\frac{l}{r_{c}}\right)^{n_{c}} + \left(\frac{r_{0}}{r_{c}}\right)^{n_{c}}\right]\right).$$

Значения параметров $V_{pp\pi}^0$, \mathbf{r}_0 , \mathbf{r}_c , \mathbf{n} и \mathbf{n}_c были взяты из работы [18]. Результаты расчета интегралов перескока приведены в табл. 2.

Энергетические характеристики электронов были получены при численном решении задачи на собственные значения гамильтониана. Результаты расчета представлены на рис. 3.

Из рисунка видно, что $(C)_{44}$ и $(C)_{63(12)}$ обладают нулевой шириной запрещенной зоны и принадлежат к полуметаллам, а $(C)_{664}$ является узкозонным полупроводником с шириной запрещенной зоны в точке M, равной 0.33 eV.

Таблица 2. Значения интегралов перескока

	(C)44	$(C)_{63(12)}$	(C) ₆₆₄
$V_{pp\pi}^0, \mathrm{eV}$	-1.83			
r_0, A	1.54			
r_c , Å	2.87			
n	2.00			
n_c	6.85			
l, Å	1.48	1.38	1.71	1.56
$V_{pp\pi}, \mathrm{eV}$	-1.997	-2.311	-1.440	-1.777

Расчет проводимости

Полная проводимость может быть представлена в виде суммы межзонной и внутризонной проводимостей $\sigma = \sigma_{inter} + \sigma_{intra}$. Будем рассматривать электрическое поле, вектор напряженности которого находится в плоскости исследуемых структур. В данной плоскости исследуемые структуры обладают изотропией по отношению к электрическим и оптическим свойствам.

Межзонная проводимость определяется выражением [19]

$$\sigma_{\text{inter}} = \frac{e^2}{2\pi m^2 \omega} \sum_{v,c} \int \int \left(f(E_v) - f(E_c) \right) \\ \times \left| R_{v,c}(\mathbf{k}) \right|^2 \delta(E_c - E_v - \hbar \omega) d^2 k, \qquad (2)$$

где f — функция Ферми. Суммирование проводится по заполненной валентной зоне (v) и свободной зоне проводимости (c). Матричные элементы оператора импульса можно выразить через матрицу гамильтониана (1):

$$\begin{split} |P_{v,c}(\mathbf{k})|^2 &= \frac{1}{2} \left| \langle \mathbf{c} | P_x | \mathbf{v} \rangle \right|^2 + \frac{1}{2} \left| \langle \mathbf{c} | P_y | \mathbf{v} \rangle \right|^2 \\ &= \frac{1}{2} \left| \langle \mathbf{c} \left| \frac{m}{\hbar} \frac{\partial H}{\partial k_x} \right| \mathbf{v} \rangle \right|^2 + \frac{1}{2} \left| \langle \mathbf{c} \left| \frac{m}{\hbar} \frac{\partial H}{\partial k_y} \right| \mathbf{v} \rangle \right|^2, \end{split}$$

где с и v — собственные векторы для собственных значений гамильтониана, принадлежащих зоне проводимости и валентной зоне соответственно.

Внутризонная проводимость определяется теорией Друде [19]

$$\sigma_{
m intra} = rac{iarepsilon_0 \omega_p^2}{\omega + i\Gamma}$$

Здесь Γ — коэффициент затухания, а ω_p — плазменная частота, определяемая выражением [19]

$$\omega_p^2 = \frac{e^2}{2\pi^2 \hbar^2 \varepsilon_0} \sum_n \iiint \left(\frac{\partial E_n(\mathbf{k})}{\partial k_x} \right)^2 \\ \times \delta(E_n(\mathbf{k}) - E) d^2 k f'(E) dE.$$
(3)



Рис. 3. Зонная структура 2D-супракристаллов: $a - (C)_{44}$, $b - (C)_{63(12)}$ и $c - (C)_{664}$. Энергия Ферми принималась равной нулю.

Интегралы в (2) и (3) были рассчитаны численно методом треугольника [20]. При этом интегралы по волновому числу заменялись суммированием по двумерным сеткам 12×12 (для (C)₄₄) и 18×18 (для (C)₆₃₍₁₂₎ и (C)₆₆₄) *к*-точек в зоне Бриллюэна. При увеличении линейного размера сетки на единицу результаты вычислений изменялись во втором знаке после запятой. Расчеты проводились для следующих параметров: $E_f = 0$ eV, $\hbar\Gamma = 10$ meV и kT = 25 meV (T = 300 K). Энергия фотонов бралась в интервале от 0 до 3 eV, который включает в себя оптический диапазон. Результаты вычислений представлены на рис. 4.

Результаты показывают, что проводимость структур $(C)_{44}$, и $(C)_{63(12)}$ выше, чем у графена. Так, например, расчеты межзонной проводимости для тех же самых значений температуры и энергии Ферми, приведенные в работе [21], дают для него значение $\sigma_{enter}/\sigma_0 = 4$. Анализ зависимостей межзонной проводимости от частоты падающего излучения (рис. 4) выявил следующее.

 $(C)_{44}$. Генерация фотоэлектронов начинается с энергии 1.72 eV, достигает максимума при энергии 2.12 eV и заканчивается при энергии 3.13 eV, что соответствует разности энергий между потолком валентной зоны и зоны проводимости в точке *S* (рис. 3, a).

 $(\mathbb{C})_{63(12)}$. Как и у графена, генерация фотоэлектронов в этой структуре начинается при практически нулевой энергии фотонов. Это связано со смыканием валентной зоны с зоной проводимостью в точке Γ (рис. 3, *b*), подобно смыканию этих зон у графена в точке *K*. Максимум проводимости наблюдается при 1.44 eV, что соответствует межзонным переходам в точке *M*. Небольшой перегиб при 1.80 eV соответствует переходам в точке *K*.

(С)₆₆₄. Генерация фотоэлектронов начинается с энергии, равной 0.33 eV, соответствующей переходам в точке M (рис. 3, c). Максимум проводимости наблюдается при 0.68 eV. Перегиб при энергии, равной 1.16 eV, соответствует переходам в точке K.

Большая по сравнению с графеном внутризонная проводимость $(C)_{44}$ и $(C)_{63(12)}$ (рис. 4, *а* и *с*) связана, по нашему мнению, с тем, что большее, чем у графена, число подзон дает больший вклад в плазменную



Рис. 4. Оптическая проводимость супракристаллов: *a*, *b* — для (C)₄₄; *c*, *d* — (C)₆₃₍₁₂₎; *e*, *f* — (C)₆₆₄. Штриховой линией показана действительная часть внутризонной проводимости, $\sigma_0 = e^2/4\hbar$. При расчетах были использованы следующие значения параметров: $E_f = 0 \text{ eV}, kT = 25 \text{ meV}, \hbar\Gamma = 10 \text{ meV}.$

частоту и, следовательно, в проводимость. Кроме того, валентная зона и зона проводимости (С)₄₄ пересекаются, что обусловливает большую концентрацию свободных носителей заряда и большую плазменную частоту.

Расчет показателя преломления

По формуле [19]

$$n = \sqrt{1 + \frac{i\sigma(\omega)}{d\omega\varepsilon_0}}$$

для исследуемых супракристаллов и графена были оценены комплексные показатели преломления $\tilde{n} = n_r + n_i i$ в направлении, параллельном их плоскостям. Значения уровня Ферми, температуры и коэффициента затухания для графена брались такими же, как и для супракристаллов. Толщина кристаллических листов d считалась равной 3.35 Å (на самом деле это расстояние между слоями в графеновой сверхрешетке). На рис. 5 показаны зависимости действительной n_r и мнимой n_i частей показателя преломления от частоты. В отличие от "прозрачного" графена супракристаллы имеют узкие зоны непропускания. Нулевое значение n_r в диапазоне от 0.85 до 1.7 eV для (C)₄₄, от 1.85 до 2.35 eV для (C)₆₃₍₁₂₎ и от 0.2 до 0.35 eV для (C)₆₆₄ показывает, что электромагнитные волны соответствующих энергий, падающие



Рис. 5. Мнимый показатель преломления: a - для (C)₄₄, $b - (C)_{63(12)}$, $c - (C)_{664}$, $d - графен. Сплошной линией показана действительная часть <math>n_r$, штриховой линией показана мнимая часть n_i .

в плоскости супракристаллов, претерпевают полное отражение. Для $(C)_{664}$ показатель преломления равен 1 в интервале от 1.6 до 3 eV, т.е. во всем оптическом диапазоне электромагнитные волны распространяются вдоль двумерного листа без преломления.

Заключение

В работе были исследованы строение энергетических зон и проводимость двумерных супракристаллов, а также были рассчитаны для них комплексные показатели преломления. Полученные результаты показывают, что две структуры ((C)₄₄ и (C)₆₃₍₁₂₎) являются полуметаллами, а (C)₆₆₄ — узкозонным полупроводником. Сравнение проводимости 2D-супракристаллов с проводимостью графена показало, что (C)₄₄ и (C)₆₃₍₁₂₎ имеют проводимость, значительно превышающую проводимость графена, что делает их весьма перспективными для использования в наноэлектронике. Ярко выраженные максимумы межзонной проводимости на определенных частотах позволяют рассматривать 2D-супракристаллы в качестве материалов для детекторов излучения соответствующих частот. Наличие областей полного отражения

электромагнитных волн, в том числе и в оптическом диапазоне, позволяет использовать их в качестве фильтров.

Работа выполнена в рамках государственного задания Министерства образования и науки РФ 2014/232 (проект № 1742).

Список литературы

- Novoselov K.S., Geim A.K., Morozov S.V., Jiang D., Zhang T., Dubonos S.V., Grigorieva I.V., Firsov A.A. // Science. 2004. Vol. 306. P. 666–669
- [2] Novoselov K.S., Jiang D., Schedin F., Booth T.J., Khotkevich V.V., Morozov S.V., Geim A.K. // PNAS. 2005. Vol. 102. P. 10451–10453.
- [3] Aufray B., Kara A., Vizzini S., Oughaddon H., Leandri Ch., Ealet B., Le Lay G. // Appl. Phys. Lett. 2010. Vol. 96. P. 183102.
- [4] Piazza Z.A., Hu H.-S., Li W.-L., Zhao Y.-F., Li J., Wang L.-S. // Nature Commun. 2014. Vol. 5. P. 3113.
- [5] Crespi V.H., Benedict L.X., Cohen M.L., Louie S.G. // Phys. Rev. B. 1996. Vol. 53. P. R13303–R13305.
- [6] Deza M., Fowler P.W., Shtorgin M., Vietze K. // J. Chem. Inf. Comput. Sci. 2000. V. 40. P. 1325–1332.

- [7] Terrones H., Terrones M., Hernandes E., Grobert N., Charller J.-C., Ajayan P.M. // Phys. Rev. Lett. 2000. Vol. 84.
 P. 1716–1719.
- [8] Baughman R.H., Eckhardt H., Kertesz M. // J. Chem. Phys. 1987. Vol. 87. P. 6687–6700.
- [9] Narita N., Nagai S., Suzuki S., Nakao K. // Phys. Rev. B. 1998. Vol. 58. P. 11009–11014.
- [10] Haley M.M., Brand S.C., Pak J.J. // Angew. Chem. Int. Ed. Engl. 1997. Vol. 36. P. 836–838.
- Bucknum M.J., Castro E.A. // Solid State Sci. 2008. Vol. 10.
 P. 1245–1251.
- [12] Браже Р.А., Каренин А.А. // Тр. 7-й Межд. конф. Математическое моделирование физических, экономических, технических, социальных систем и процессов. Ульяновск. 2009. С. 51.
- [13] Karenin A.A. // J. Phys.: Conf. Ser. 2012. Vol. 345. P. 012025.
- [14] Браже Р.А., Каренин А.А., Кочаев А.И., Мефтахутдинов Р.М. // ФТТ. 2011. Т. 53. Вып. 7. С. 1406–1408.
- [15] Браже Р.А., Кочаев А.И., Мефтахутдинов Р.М. // ФТТ. 2011. Т. 53. Вып. 8. С. 1614–1617.
- [16] Браже Р.А., Кочаев А.И. // ФТТ. 2012. Т. 54. Вып. 8. С. 1512–1514.
- [17] Sheng X.-L. et al. // J. Appl. Phys. 2012. Vol. 112. P. 074315.
- [18] Goodwin L.J. // J. Phys.: Condens. Matter. 1991. Vol. 3. P. 3869–3878.
- [19] *Pedersen T.G.* Electric, optical and magnetic properties of nanostructures. Aalborg university, 2015. 339 p.
- [20] Pedersen T.G., Flindt C., Pedersen J., Jauho A.-P., Mortensen N.A., Pedersen K. // Phys. Rev. B. 2008. Vol. 77. P. 245431.
- [21] Stauber T.R., Peres N.M., Geim A.K. // Phys. Rev. B. 2008. Vol. 78. P. 085432.